

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827, 438/464 , 438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally wax 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning reedler 14 and finally the wax 13 is removed and then the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japic

12 公開特許公報 (A)

昭60-10756

51 Int. Cl.
H 01 L 21/92

識別記号

序内整理番号
7638 5F

33公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

54 ビームリード型半導体装置の製造方法

東京都港区芝五丁目133番1号日本電気株式会社内

公特 願 昭58-119143

11出願人 日本電気株式会社

公出願 昭58(1983)6月30日

東京都港区芝五丁目133番1号

発明者 繩巻義雄

代理人 理士 内原晋

明細書

1. 発明の名称

ビームリード型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ビームリード型半導体素子の形成されたウェーハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェーハーを裏面から選択的にエッティング除去してペレットに分離する工程と、前記ワックスを除しペレット底面用治具にて前記平板から前記ペレットを分離する工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、吸められた洗浄用受け皿内にて、吸めた有機溶剤によってワックスを除去する工程とを含むことを特徴とするビームリード型半導体装置の製造方法。

3. 発明が属する技術

本発明はビームリード型半導体装置の製造方法に関するもの。

従来ビームリード型半導体装置の製造方法は、所定のビームリード型半導体素子の形成された半導体基板の上面にリックスを塗布し石英板と貼り合せし後、該半導体基板の裏面にレジストにてパターンを形成し酸洗液で半導体ウエーハーを選択的にエッティング除去してペレット状に分離し、次にペレット1個につき押して再配列するのに100～200℃の高圧のホットプレート上でワックスをだしへペレット底面用治具にてペレットと石英板とを分離後、半導体ペレットに付着ワックスを予め加熱ヒーターで有機溶剤を吸めた有機溶剤をスプレーガンで3～5分間吹付けで除去し別の配列板に並べていた。

しかし上記方式のペレットハンドリングプロセスは、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石英板とがワックスによって貼り合わせておりとのりワックスを100～200℃の高圧のホットプレート上で石英板と離れてワックスを落かし、ペレット底面用治具にてペレットと石英板とを分離後、

半導体ペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを、50～100℃の温度範囲の加熱ヒーターにて予め有機用熱を吸めスプレーガンで吹付時30～35℃範囲の有機溶剤を3～5秒間吹付けてワックスを除去し別の配列板に並べているがペレットサイズによってワックス洗浄時間がかかり過ぎたワックスが完全に取りきれない場合もあった。

ペレットの配線面及び裏面にワックスが残っていると、ペレットの信頼性及び歩留りを悪くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を長くしたりするため作業能率を悪くする欠点を持っていた。

本発明は上記欠点を除去し半導体装置の信頼性及び歩留りを大幅に向上させることのできる半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体電子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェハーを裏返から選択的にエッティング除去してペレットに分離する工

- 3 -

程する。

次には3図に示すようにペレット15の配線面及び裏面に付着しているワックス13を50～100℃温度範囲の加熱ヒーター21によって予め有機溶剤と、洗浄用空氣18も加熱ヒーター19によって50～100℃の温度範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付時35～40℃範囲の有機溶剤を3～4秒間吹付けてワックスを除去した(第4回)後、別の配列板22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペレットの配線面及び裏面に付着しているワックスを予め吸めた有機溶剤と洗浄用空気も含めることにより有機溶剤を吸い込んでペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩留り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに關係なく短時間でペレットハンドリングが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

- 5 -

-282-

群と、加熱によりドライカクを付しペレット表面用の熱で自ら熱からペレットを分離する工程と、前記ペレットの裏返してあるワックスを、脱離された歩留りの有機溶剤にて除去する工程と、前記ペレットを分離する工程とを含む半導体装置の製造方法である。

以下歩留りに及ぼす影響をお顧して本発明を詳細に説明する。

まず第1回に示すように、通常のビームリード型電子の形成された半導体ウェハーを、前記ビームリード2が下になるよう裏返して、例えばスカイコートなどのワックス3を用いて石英などの平板4に貼り付ける。

次に前記半導体ウェハーの裏面にレジストバターンを形成し、該バターンをマスクにしてガラス用いて該ウェハーを選択的にエッティング除去し、第2回に示すようにペレット5に分離する。次に100～200℃のホットプレート7の上で石英板4を磨めてワックス3を落かしペレット表面用前具6を用いてペレット5を石英板4から分離する。

- 4 -

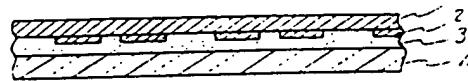
第1回乃至第4回は本発明の実施例を説明する為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2 ……ビームリード、3 ……ワックス、4 ……石英板、5 ……ペレット、6 ……ペレット吸石用前具、7 ……ホットプレート、18 ……洗浄用空氣、19 ……洗浄用空氣の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……有機溶剤の加熱ヒーター、22 ……ガラス板である。

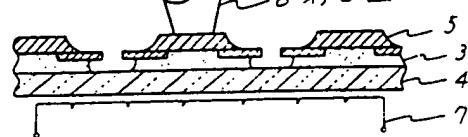
代理人弁理士 内原

- 6 -

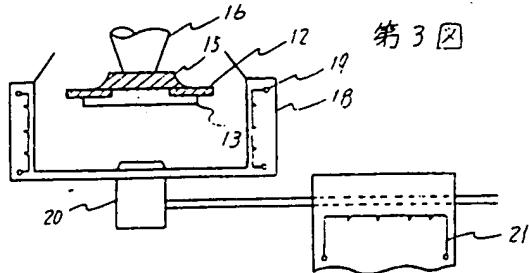
第1図



第2図



第3図



第4図

